

kHz输出晶体振荡器 KC2520B系列(32.768kHz)

CMOS/ 1.8V~5.0V/ 2.5×2.0mm



RoHS指令对应产品

### ■特点

- 小型低背陶瓷封装  
2.5(L)×2.0(W)×0.7(H)mm(Typ.)
- 用缝口密封的高可靠性
- CMOS输出
- 电源电压 可以用于这些规格 1.8/ 2.5/ 3.3/ 5.0V  
可对应广泛的电源电压范围 1.6~5.5V
- 低电流消耗类型

### ■用途

- 消费类电子产品 / 手机设备

### ■型号表示方法

KC2520B 32K7680 C M 2 E 00  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- ①系列名称
- ②输出频率(32.768kHz)
- ③输出形式(CMOS)
- ④电源电压(可以用于这些规格 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V)
- ⑤频率容差(参见下表)
- ⑥对称 / INH功能(45/ 55%)
- ⑦个别规格(产品目录以00标示)

包装方式(载带包装 2000个/ 卷盘)

### ■规格

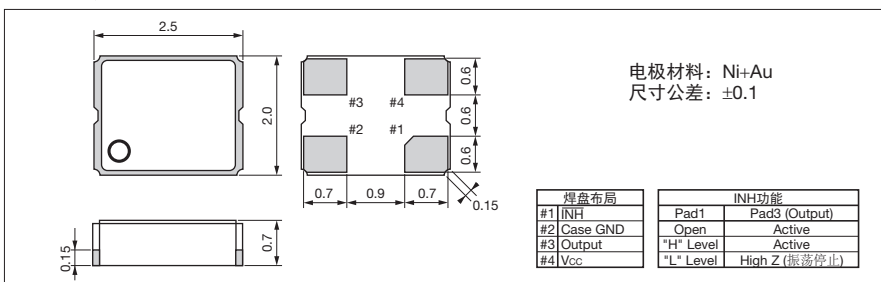
项 目	记 号	条 件	规 格		单 位
			Min.	Max.	
输出频率范围	f <sub>o</sub>		32.768		kHz
频率容差	f <sub>tol</sub>	初始(25°C)、温度特性(-40 ~ 85°C)、电源电压变化	-25	+25	×10 <sup>-6</sup>
		老化(@1年)	-3	+3	
		其他(负载变动、振动和冲击)	-4	+4	
存储温度范围	T <sub>stg</sub>		-55	+125	°C
工作温度范围	T <sub>use</sub>		-40	+85	°C
最大的额定电压	—		-0.3	+7.0	V
电源电压	V <sub>cc</sub>		+1.6	+5.5	V
电流消耗 (最大负载时/ 1.6≤V <sub>cc</sub> ≤2.0V)	I <sub>cc</sub>		—	120	μA
电流消耗 (最大负载时/ 2.0<V <sub>cc</sub> ≤2.8V)			—	126	
电流消耗 (最大负载时/ 2.8<V <sub>cc</sub> ≤3.63V)			—	130	
电流消耗 (最大负载时/ 3.63<V <sub>cc</sub> ≤5.5V)			—	140	
待机时电流	I <sub>std</sub>		—	10	μA
波形对称	SYM	@50% V <sub>cc</sub>	45	55	%
上升/下降时间 (10%V <sub>cc</sub> ~90%V <sub>cc</sub> 最大负载时)	Tr/ Tf		—	50	ns
L电平输出电压	V <sub>oL</sub>	I <sub>oL</sub> = 1mA	—	10% V <sub>cc</sub>	V
H电平输出电压	V <sub>oH</sub>	I <sub>oH</sub> = -1mA	90% V <sub>cc</sub>	—	
输出负载条件(CMOS)	L <sub>CMOS</sub>	CMOS Output	—	15	pF
L电平输入电压	V <sub>iL</sub>		—	30% V <sub>cc</sub>	V
H电平输入电压	V <sub>iH</sub>		70% V <sub>cc</sub>	—	
禁用时间	t <sub>dis</sub>		—	100	ns
启用时间	t <sub>ena</sub>		—	2	ms
振荡启动时间	t <sub>str</sub>	最小动作电压为0sec.。	—	5	ms

所有的电气特性是以最大负载时, 并在工作温度范围内为条件。

kHz  
晶体  
元件

### ■外形尺寸

(单位: mm)



### ■推荐焊盘图案

(单位: mm)

